

Electronic Journal 第629回 Technical Seminar

サファイア基板とその加工技術

主催：電子ジャーナル

日時：12月8日（水）10:00～16:45

会場：総評会館

定員：40名 ※定員になり次第、締め切らせて頂きます。お早めにお申込み下さい。

LEDやLD、高周波デバイスなどのGaNデバイスの需要が増えています。このため、GaNウェーハの成長に使用されるサファイア基板の面積化が進んでいます。現在の2～4インチ基板から、6インチ基板の量産技術開発が急ピッチに進められていますが、面積基板の結晶化技術、スライスや平坦化技術などの加工技術のさらなるブラッシュアップが求められています。将来的にはGaNデバイスのパワー半導体への応用も視野に入れられており、6インチ基板のいち早い量産・低コスト化技術の開発が求められています。本セミナーでは、結晶化、基板加工、加工設備の観点から、現状の課題と解決に向けた取り組み、各装置メーカーの取り組みなどについて徹底解説します。

《プログラム》

【10:00～11:00】①LED用サファイア基板の最新技術動向と課題

並木精密宝石(株) エヌ・ジェイ・シー技術研究所 マネージャー 会田英雄氏

【11:05～12:05】②大口径サファイア単結晶の製造技術

信州大学 工学部 客員教授 干川圭吾氏

【12:45～13:45】③LED&電子デバイス用サファイア基板

Saint-Gobain Crystals Photonics Global R&D Manager Christopher D. Jones氏

【13:50～14:40】④サファイアウェーハのスライシング技術

(株)タカトリ 営業本部 MWS機器営業部 部長 清水成晃氏

【14:50～15:40】⑤サファイア基板平坦化技術

テクノライズ(株) 技術部 部長 谷口佳伸氏

【15:45～16:35】⑥サファイア基板のダイシング技術

ロフィン・バーゼルジャパン(株) 営業部 マネージャー コアレーズ担当 山田一雄氏

【16:35～16:45】名刺交換会